

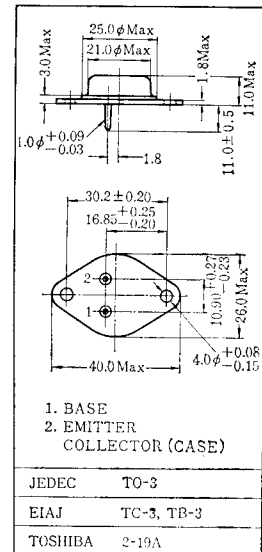
シリコンNPN拡散接合形トランジスタ
SILICON NPN DIFFUSED JUNCTION TRANSISTOR

2SD113, 2SD114

- 低周波大電力増幅用
- 大電力スイッチング用
- DC—DCコンバータ用
- 電源レギュレータ用
- Audio Power Amplifier Power Switching Application,
DC—DC Converter and Regulator Applications.

通信工業用
Industrial Applications

Unit in mm



アクセサリはAC73を適用
MOUNTING KIT NO. AC73

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	100	V
		70	
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	80	V
		50	
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	10	V
コレクタ電流	I _C	30	A
エミッタ電流	I _E	—30	A
ベース電流	I _B	5	A
コレクタ損失	P _C	200	W
		40	
接合温度	T _J	150	°C
保存温度	T _{stg}	—65~150	°C

Note 1; シリコン・グリースを塗布し、マイカ絶縁板を介して 300×300×2mm Al 放熱板を取付けたとき。

Unit mounted on a 300×300×2mm Al, heat sink with silicone greased mica insulator.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} =50V, I _E =0	—	—	2	mA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =10V, I _C =0	—	—	50	mA
コレクタ・ベース間降伏電圧	V _{(BR)CBO}	I _C =10mA, I _E =0	100	—	—	V
			70	—	—	
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	V _{(BR)CEO}	I _C =50mA, R _{BE} =∞	80	—	—	V
			50	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	V _{(BR)EBO}	I _E =50mA, I _C =0	10	—	—	V
直流電流増幅率	h _{FE(1)} (Note 2)	V _{CE} =5V, I _C =1A (Note 3)	30	—	300	
	h _{FE(2)}	V _{CE} =5V, I _C =15A (Note 3)	10	12	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =15A, I _B =3A (Note 3)	—	0.8	1.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =15A, I _B =3A (Note 3)	—	1.6	2.5	V
トランジション周波数	f _T	V _{CE} =10V, I _C =1.0A	—	1.5	—	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} =50V, I _E =0, f=1MHz	—	400	—	pF
スイング時間	ターンオン時間	Fig 1	—	3	—	μs
	蓄積時間		—	5	—	μs
	下降時間		—	5	—	μs